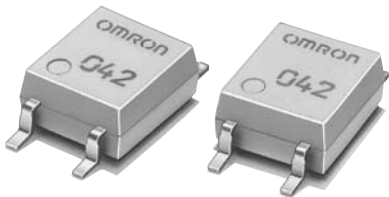


G3VM-41GR4 MOS FET继电器

实现低C×R=10pF・Ω的新型MOS FET继电器
负载电压40V型

- 可抑制输出信号衰减的导通电阻=2Ω(标准)。
- 开路时漏电流1.0nA(最大)。

符合RoHS (详情请参见<http://www.omron.co.jp/ecb/>。)



※标记内容与实际商品有所不同。

⚠ 请参见第6页的「共通注意事项」。

■用途示例

- 半导体检查设备
- 计测仪器
- 宽带
- 数据记录仪

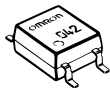
■种类

接点结构	端子种类	负载电压	型号	包数	捆包数量
1a	表面安装端子	AC40V峰值	G3VM-41GR4	100	—
			G3VM-41GR4 (TR)	—	2,500

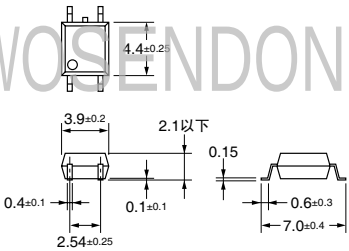
■外形尺寸

(单位: mm)

G3VM-41GR4



WWW.WOSENDONGLI.COM

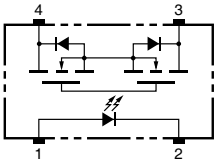


※标记内容与实际商品有所不同。

文件CAD G3VM_16 质量: 0.1g

■端子布置/内部接线图 (俯视图)

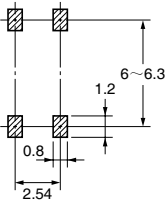
G3VM-41GR4



■安装衬垫尺寸 (推荐值) (俯视图)

(单位: mm)

G3VM-41GR4



绝对最大额定 (Ta=25℃)

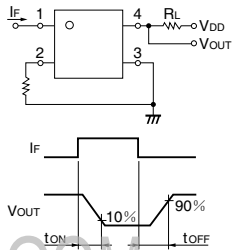
项目		符号	额定	单位	条件
输入侧	LED正向电流	IF	50	mA	
	反复峰值LED正向电流	IFP	1	A	100μs脉冲、100pps
	直流正向电流降低比率	ΔIF/℃	-0.5	mA/℃	Ta≧25℃
	LED反向电流	VR	5	V	
	粘合部位温度	TJ	125	℃	
输出侧	输出耐压	VOFF	40	V	
	连续负载电流	Io	250	mA	
	导通电流降比率	ΔION/℃	-2.5	mA/℃	Ta≧25℃
	粘合部位温度	TJ	125	℃	
输入输出间耐压 (注1)		VI-O	1500	Vrms	AC持续1分钟
使用环境温度		Ta	-20~+85	℃	不结冰、凝露
贮藏温度		Tstg	-55~+125	℃	不结冰、凝露
焊接温度条件		—	260	℃	10s

(注1): 测量输入输出间的耐压时, 分别对LED针脚、受光测针脚统一地施加电压。

电气性能 (Ta=25℃)

项目		符号	最小	标准	最大	单位	条件
输入侧	LED正向电压	VF	1.0	1.15	1.3	V	IF=10mA
	反向电流	IR	—	—	10	μA	VR=5V
	端子间电容	CT	—	15	—	pF	V=0、f=1MHz
	触发LED正向电流	IFT	—	—	4	mA	Io=100mA
输出侧	最大输出导通电阻	RON	—	2.0	3.0	Ω	IF=5mA、Io=250mA、t<1s
	开路时漏电流	I LEAK	—	—	1.0	nA	VOFF=30V、Ta=50℃
	端子间电容	COFF	—	5.0	7.0	pF	V=0、f=100MHz、t<1s
输入输出间电容		CI-O	—	0.8	—	pF	f=1MHz、Vs=0V
输入输出间电容绝缘电阻		RI-O	1000	—	—	MΩ	VI-O=500VDC、RoH≧60%
动作时间		TON	—	—	0.5	ms	IF=10mA、RL=200Ω、VDD=20V (注2)
回复时间		TOFF	—	—	0.5	ms	

(注2): 动作·回复时间



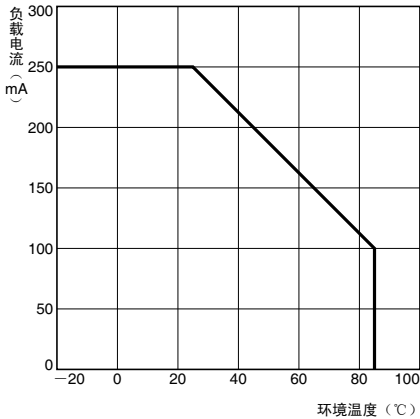
推荐动作条件

为了保证继电器的正确动作和回复, 请在以下条件下使用。

项目	符号	最小	标准	最大	单位
输出耐压	VDD	—	—	32	V
动作LED正向电流	IF	10	—	30	mA
连续负载电流	Io	—	—	250	mA
动作温度	Ta	25	—	60	℃

参考数据

负载电流—环境温度
G3VM-41GR4



请正确使用

·共通注意事项、请参见第6页。